

Si DRIE

适用于深硅蚀刻的高精度Si DRIE系统，具备出色的各向异性与均匀性。
专为MEMS、电力器件与先进半导体应用而设计。

Cetus, Capella

SPT提供两款Si DRIE系统——Predeus与Proxion——专为实现高深宽比深硅蚀刻而设计。两款平台均具备稳定、可重复的工艺性能，具备优异的均匀性与工艺控制，广泛适用于MEMS与先进封装应用。

Applications:

- ✓ MEMS器件
- ✓ 功率半导体器件
- ✓ 光学器件
- ✓ 喷墨打印头
- ✓ 硅通孔 (TSV)

FEATURES

为何选择SPT高精度Si DRIE系统



业界领先的蚀刻速率与选择性

在保持垂直轮廓、侧壁光滑与最小CD损耗的前提下，SPT的Si DRIE系统实现业界领先水平的蚀刻速率与高选择性。



丰富的工艺库，支持多种蚀刻轮廓

系统配备广泛的深硅蚀刻工艺库，支持快速配方开发与高重复性生产。



兼容先进半导体应用

理想适用于功率MOSFET、200mm与300mm晶圆上的TSV形成，以及其他需要深度高深宽比结构的先进器件架构。

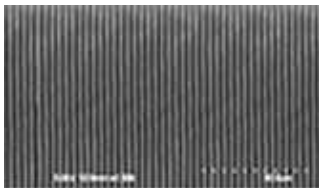


灵活系统配置，适配从研发到量产

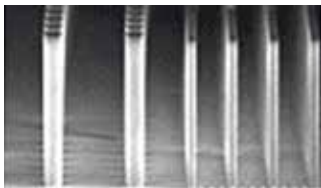
从真空LoadLock系统到全自动集群系统，SPT提供可扩展平台，支持研发与大批量Si DRIE制造。

PERFORMANCE

高深宽比、高速蚀刻与TSV形成的卓越性能



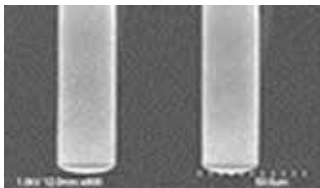
高深宽比蚀刻



圆柱结构蚀刻



高速蚀刻



硅通孔 (TSV) 蚀刻

Specifications



Process Module	Predeus	Proxion
晶圆尺寸 (mm)	200	200
搬送系统	APX, DPX, VPX, CPX	APX, DPX, VPX, CPX
蚀刻速率	Moderate	High
基板类型	Si	Si
应用领域	MEMS Gyroscope, MEMS Accelerometer	MEMS Microphone, Inkjet Printhead Manufacturing



APX



DPX



VPX



CPX

Platform	APX	DPX	VPX	CPX
预期用途	R&D	Prototype	Small Volume	Mass Production
腔体数量	1	2	3	4
搬送Robot	-	Atmospheric	Vacuum	Vacuum
Robot运输方式	2-Axis	2-Axis	3-Axis	3-Axis
Casseete数量	0	2	1	2

